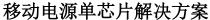
### TP4212A/TP4212B/TP4212C\_DB1





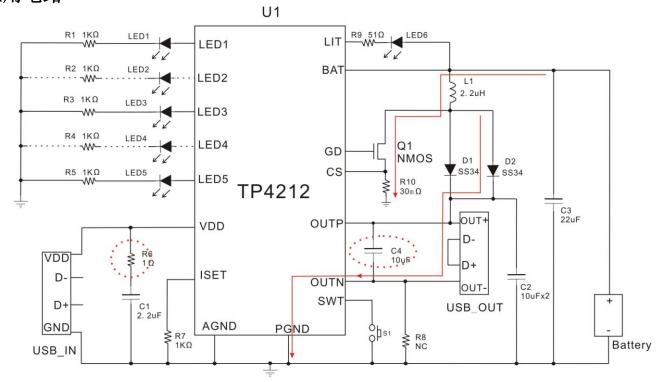
### 概述

本方案是专为移动电源设计的单芯片解决方案,TP4212X内部集成了充电管理模块、放电管理模块、保护模块、电量检测、LED指示模块以及温度补偿、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出重载保护以及输出短路保护等安全保护,可以完全取代传统的"充电IC+升压IC+MCU+保护IC"方案。

## 方案特性

- ◆ 输入电压: 4.3V~6V
- ◆ 充电电流:1A
- ◆ 放电输出电流: 2.1A
- ◆ 输出电压: 5V
- ◆ 放电时当电池电压低于 3.1 V, LED1 以 1HZ 频率闪烁提示, 电压低于 2.9V 后关闭 IC, 待机电流 < 8uA
- ◆ 负载自动检测,负载接入时自动唤醒,当负载电流减小到 50mA 以下或负载移除后 16S,进入待机模式,待机电流<8uA
- ◆ 可选 3/4/5 档电量指示
- ◆ 预设 4.2V 充电电压,精度达±1%
- ◆ 充电时当芯片内部温度大于 120℃时, 充电电流开始减小, 当温度升高到 140℃时, 充电电流减小到零
- ◆ 当电池电压低于 2.9V 时,以涓流模式充电,涓流充电电流为正常充电电流的 1/10,当电池电压充到 4.2V 时,进入恒压充电模式,充电电流逐渐减小,当减小到正常充电电流的 1/10 时,充电过程结束
- ◆ 最高达 90%的放电效率
- ◆ SOP16 封装

## 应用电路

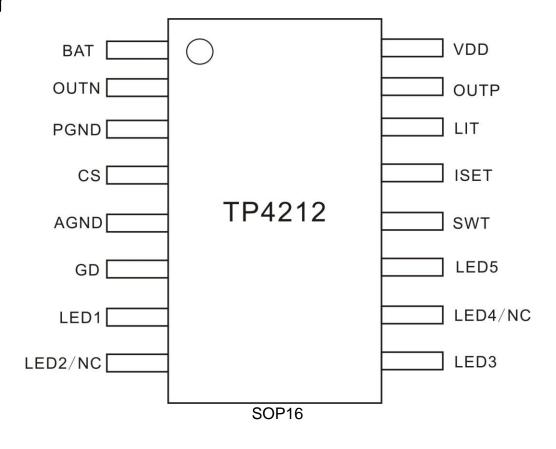




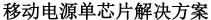
# 元件清单

序号	料号	型号	封装	数量.
1	U1	TP4212X	SOP16	1
2	D1, D2	SS34	SMA	2
3	Q1	$NMOS(R_{ON}<40m\Omega)$	SOT23-3 (SOP8)	1
4	LED1 $\sim$ LED5	绿(红)光 LED 灯	0805	5
5	LED6	50mA 白光 LED 灯	Ф5	1
6	R1∼R5,R7	1 ΚΩ	0805	6
7	R6	1Ω	0805	1
8	R8	NC	0805	1
9	R9	51Ω	0805	1
10	R10	30mΩ	1206	1
11	L1	2.2uH/5A	SMD	1
12	C1	10uF	0805	1
13	C2	10uF	0805	2
14	C3	22uF	0805	1
15	C4	10uF	0805	1
16	S1	按键	SMD	1

## 芯片管脚



### TP4212A/TP4212B/TP4212C DB1



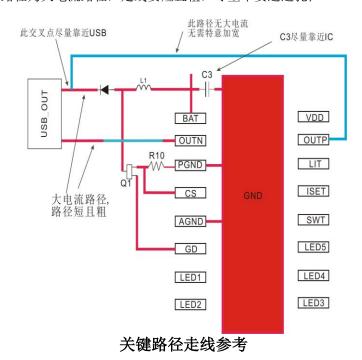


#### 应用关键点

- 1、输出 D+/D-若不加分压电阻则需要短接,否则对某些品牌手机不能充电(比如苹果);如果加分压电阻,则需保证分压电阻的总等效电阻至少为 OUTN 等效电阻的 6 倍以上,否则插入负载时有可能自动检测不到负载而需按键开机;OUTN 默认电阻为 50K,可以在 OUTN 于 GND 并联电阻以减小 OUTN 的总等效电阻。
- 2、输出电容 C2/C4 选择质量较好的低 ESR 的贴片电容,否则会影响输出纹波;
- 3、2.1A 输出时电感 L1 的饱和电流需大于 5A, 否则因电感饱和可能会导致芯片工作不正常;
- 4、Q1 选择导通电阻小的 NMOS, 2.1A 输出时 Q1 的内阻需小于 40 毫欧, 否则会影响效率, 特别是如果选用 SOT23-3 封装的时候, 若 Q1 导通电阻较大, 还可能会因为发热严重而烧毁;
- 5、2.1 电流输出时 CS 采样电阻 R10 的总功耗为 0.2W, 建议使用一颗 1206 电阻或 2 颗 0805 电阻并联。
- 6、 肖特基二极管 D1/D2 尽量选择大电流低电压的二极管,建议选用 SS34,否则会发热严重且影响效率;
- 7、TP4212X 集成了过充保护、过放保护、充电温度补偿、过温保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重保护机制,另外可以在 VDD 与地之间加一个稳压管 ZD 以避免 VDD 输入电源纹波太高;
- 8、 充电时, LED1~LED5 根据电量逐级闪烁, 充满后全亮, 充电时短按按键无效; 放电时, LED1~LED5 显示电量; 待机时短按按键显示电量 16S 后关闭; 长按按键 1.2S, 可以打开或关闭手电筒;
- 9、此方案可以分别为 3/4/5 档电量指示,其中 LED4,在做 4 个灯电量指示的情况下不需要接,LED2,LED4 做 3 个灯电量指示得时候不需要接;
- 10、R1~R5 若要求不高,可以只用一颗电阻;
- 11、5V 输出端的 USB 外壳不能接 GND, 需浮空;
- 12、应用图中红色标记的两条路径为大电流路径,走线要短且粗,尽量不要过过孔。

## PCB 设计参考

- 1、IC 下面敷铜散热, 散热面积尽量大且散热的地方留一些通孔增强散热;
- 2、AGND、PGND 直接打到 IC 下面的散热敷铜上;
- 3、BAT 与地的电容 C3 靠近 IC 的 BAT 和 GND 管脚, BAT+和 BAT-需先经过 BAT 电容再到 IC, 各 GND 走线要尽量粗, 空余的地方全部走 GND;
- 4、应用图中红色标记的两条路径为大电流路径,走线要短且粗,尽量不要过过孔;



注: 红色为正面,蓝色为反面。PCB 关键走线参考只是针对关键元件及走线的一个参考示意,还需结合实际的 PCB 要求。